

- Charakteristik :
- ◆ Spektralbereich 400 ... 1100 nm
 - ◆ strahlungsempfindliche Fläche \varnothing 2,52 mm bzw. \varnothing 3,57 mm
 - ◆ Si-PIN-Photodioden für Photodioden- und Photoelementbetrieb
 - ◆ geringes Dunkelstromniveau, hoher Nullpunktwidestand und hohe spektrale Empfindlichkeit
 - ◆ hermetisches TO39 - Gehäuse

- Applikationen :
- ◆ universelle Detektoren für Anwendungen im sichtbaren und nahen IR-Bereich
 - ◆ Messung lichttechnischer Größen, Farbmessung und -analyse
 - ◆ Röntgenstrahldosimetrie

- Grenzwerte :
- ◆ Sperrspannung 20 V
 - ◆ Betriebstemperaturbereich -25 °C ... +85 °C
 - ◆ Lagertemperaturbereich -40 °C ... +100 °C
 - ◆ Löttemperatur (3s) 260 °C

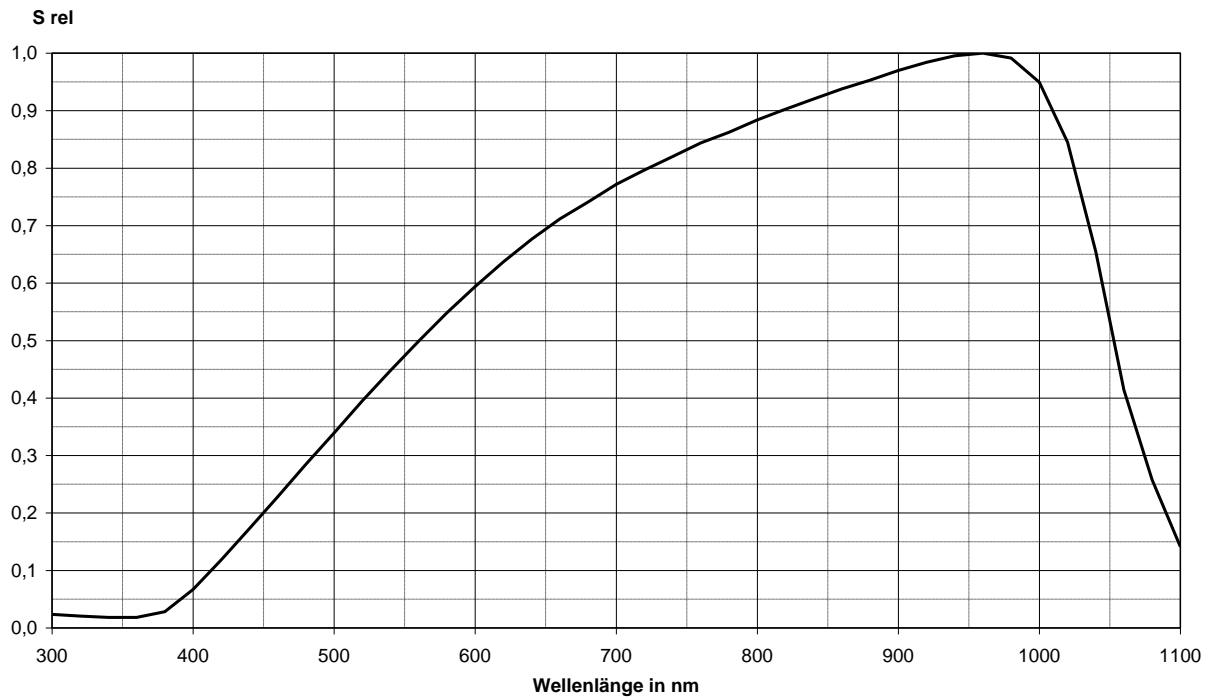
Technische Daten :

Allgemeine Meßbedingungen, sofern nicht anders spezifiziert: $T_A = 25\text{ °C}$, $V_R = 0\text{ V}$
typ. Werte, Grenzwerte in Klammern

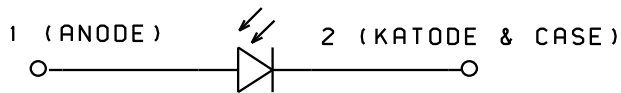
Parameter	Meßbedingung	JE 5	JE 10	Einheit
strahlungsempfindliche Fläche A		5	10	mm ²
Max. der spektralen Empfindlichkeit S_{\max} bei		950	950	nm
Spektralbereich	$S = 0,1 \cdot S_{\max}$		400 1100	nm nm
absolute spektrale Empfindlichkeit	$\lambda = 950\text{ nm}$	0,62	0,62	A/W
Dunkelstrom I_R	$V_R = 5\text{ V}$ $E = 0\text{ lx}$	1 (10)	2 (20)	nA
Anstiegszeit Abfallzeit des Fotostromes	$R_L = 50\ \Omega$, $\lambda = 850\text{ nm}$ $V_R = 0\text{ V}$ $V_R = 10\text{ V}$	2 15	2 20	μs ns
N.E.P	$\lambda = 850\text{ nm}$	$1,5 \cdot 10^{-14}$	$2,9 \cdot 10^{-14}$	W/Hz ^{1/2}
Kapazität	$V_R = 0\text{ V}$ $V_R = 10\text{ V}$	90 10	150 18	pF pF

Rev. 2 (8/2006)

Relative spektrale Empfindlichkeit



Innenschaltung



Gehäuseabmessungen

